

КТ918

кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
n-p-n транзистор

Назначение

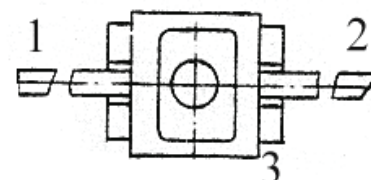
Кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n СВЧ транзистор КТ918А-2, КТ918Б-2 предназначен для применения в усилительных и генераторных гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

Обозначение технических условий

- аАО.336.006 ТУ

Корпусное исполнение

- бескорпусное исполнение



Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	Коллектор
№3	База

Таблица 2. Основные электрические параметры КТ918 при $T_{\text{окр. среды}} = (25 \pm 10) \text{ } ^\circ\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	$I_{кбо}$	мА	$U_{кб}=30\text{В}$	-	2
Емкость коллекторного перехода*	C_k	пФ	$U_{кб}=15\text{ В } f=10\text{МГц}$	-	4,2
Ёмкость эмиттерного перехода	$C_э$	пФ	$U_{эб}=0\text{ } f=10\text{МГц}$	-	15
Граничная частота коэффициента передачи тока*	$F_{гр}$	ГГц	$U_{кэ}=10\text{В } f=300\text{МГц}$ $I_{к}=100\text{мА}$	0,8	-
КТ918А-2				1	-
КТ918Б-2					
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мкА	$U_{эб}=2,5\text{ В}$	-	100
Медианное значение выходной мощности	$P_{вых}$	мВт	$U_{кб}=20\text{В } f=3\text{ГГц}$		
КТ918А-2			$P_{вых}=125\text{мВт } I_{к}=100\text{мА}$	250	-
КТ918Б-2			$P_{вых}=250\text{мВт } I_{к}=120\text{мА}$	500	-

* справочные параметры

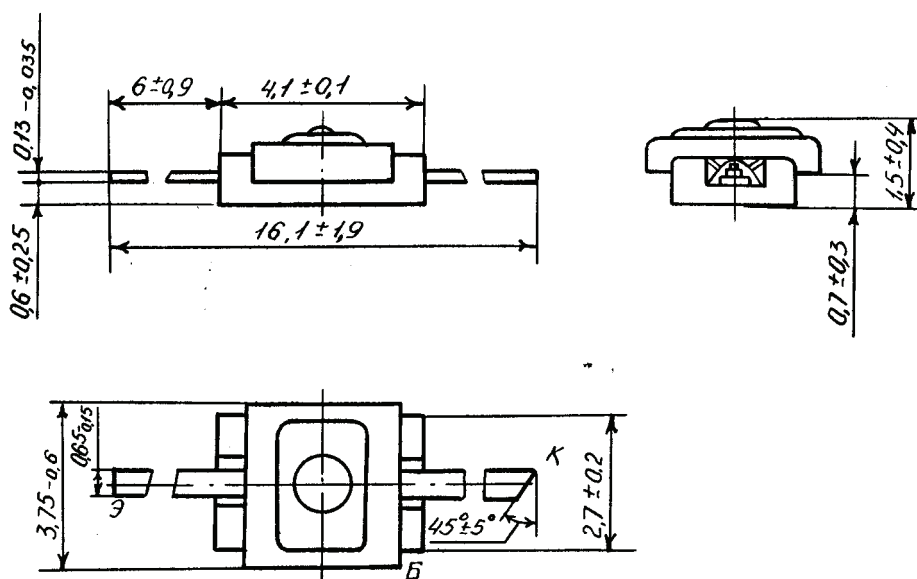


Рисунок 1. Габаритный чертеж КТ918А-2, КТ918Б-2